

Semiconductor Equipment List

Product model		VF-5900	VF-5700	VF-5300	VF-5100	VF-3000	VF-1000	Model 200	Model 206A	S02-12-F	S02-12L-F	S02-30L-F	S02-60-F	VES-4000	RLA-1200	RLA-3100	RLA-3100-V	RLA-4106-V	RLA-4200-V	VF-5300HLP	VF-5300H	VF-3000HLP	VF-3000H	CLH
Wafer size	φ300mm	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	φ200mm	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Up to φ150mm	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○
	600 × 600mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510 × 515mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 × 300mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○
Batch size [Maximum storage count / system]	φ300mm	100	50	-	-	-	25	-	-	100 * ²	104 * ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
	φ200mm	-	-	150	150	50	25	125	-	100 * ²	-	-	-	-	1	1	1	1	2	100	75	-	50	200
	Up to φ150mm	-	-	200	150	75	50	150	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	100	100	50	75	200
	600 × 600mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 * ²	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	510 × 515mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 * ²	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300 × 300mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 * ²	-	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Other (Rectangular substrate etc)	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
*1 Subject to consultation *2 It may vary depending on wafer thickness and warpage.																								
Transfer system	Wafer (substrate)	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
	Cassette stocker	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-
	FOUP opener	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FOUP stocker	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMIF Pod opener	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-
System	Vertical Furnace	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-
	Horizontal Furnace	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lamp Annealing System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	Clean Oven System	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Large Bore Vertical Furnace	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SiC Power Semiconductor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Semiconductor	Annealing	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	Thermal oxidation	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-
	LPCVD (SiN, Poly-Si (Non-Doped, P-Doped) TEOS, HfO ₂)	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Activated annealing	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
	Impurity diffusion	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Polyimide curing	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Gettering	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Sintering / Alloy	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SiC Power Semiconductor	Activated annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
	Thermal oxidation	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Nitriding / Oxynitriding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	Contact annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
MEMS	Thermal oxidation	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VCSEL	Thermal oxidation	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contact annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	Anneal	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PV (Photovoltaic)	Impurity diffusion	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thermal oxidation	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Packaging	Polyimide cure	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Bake	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
FPD	Curing (Polyimide curing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
	Activation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dehydrogenation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Frit firing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Metal contact annealing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-